SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Patent number:

JP5030350

Publication date:

1993-02-05

Inventor:

NAKAMURA SATOYUKI; others: 01

Applicant:

Classification: - international: MINOLTA CAMERA CO LTD

- european:

Application number:

H04N1/40; H01L27/14; H01L31/10; H04N1/028; H04N5/335

JP19910178170 19910718

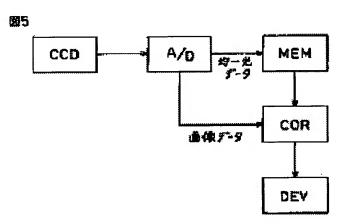
Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of JP5030350

PURPOSE: To simply correct ununiformity of sensitivity between picture elements in the solid-state image pickup device provided with a solid-state image pickup element having a characteristic in which an output voltage with respect to a light received quantity is changed in natural logarithm.

CONSTITUTION:An image pickup data for each picture element at uniform light exposure is stored in a memory MEM. A correction arithmetic operation circuit COR subtracts an image pickup data at uniform exposure stored in the memory MEM from the image pickup data for each picture element at an actual image pickup to correct the ununiformity of the sensitivity among picture elements.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-30350

(43)公開日 平成5年(1993)2月5日

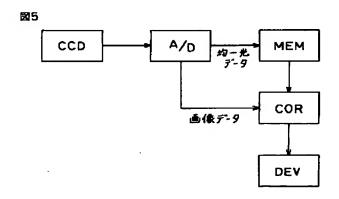
(51)Int.Cl. ⁵ H 0 4 N 1/40 H 0 1 L 27/14 31/10	識別記号 101 A -	庁内整理番号 9068-5C	FI		-	技術表示箇所
51,710		8223-4M 8422-4M	H01L 審査請求 未請求	27/ 14 31/ 10 対 請求項の数 1(Z Z 全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号 (22)出願日	特願平3-178170 平成3年(1991)7月18日		(71)出願人	, 000006079 ミノルタカメラ株式会社 大阪府大阪市中央区安土町二丁目 3 番13号 大阪国際ビル		
			(72)発明者		上町二丁目	
			(72)発明者	高田 謙二 大阪市中央区安 国際ピル ミノ		

(54) 【発明の名称 】 固体撮像装置

(57)【要約】

【目的】受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変化する特性を有する固体撮像素子を備えた固体撮像装置において、各画素間の感度の不均一性を簡単に補正する。

【構成】均一光照射時の各画素毎の撮像データをメモリー(MEM)に記憶する。補正演算回路(COR)は、実際の撮像時における各画素毎の撮像データからメモリー(MEM)に記憶された均一光照射時の撮像データを減算することにより、各画素間の感度の不均一性を補正する。



(2)

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】受光量に対してその出力電圧が自然対数的 に変化する特性を有する固体撮像素子を備えた固体撮像 装置において、

均一光照射時の撮像データを各画素毎に記憶する記憶手 段と、

実際の撮像時における各画素毎の撮像データから上記記 憶手段に記憶された対応する画素の撮像データを減算す ることにより固体撮像素子各画素間の感度の不均一性を 補正する補正手段と、

を有することを特徴とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、固体撮像装置に関し、 特に受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変化す る特性を有する固体撮像素子を備えた固体撮像装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】従来から使用されてきた固体撮像素子は、受光量に対してその出力電圧がリニアに変化するという特性を有している。このリニアな特性をもつ固体撮像素子は各画素毎に感度が異なっており、感度の違いによってたとえ均一光を照射したとしても各画素間の出力に差が生じる。

【0003】図1は、上記従来の固体撮像素子の受光量 Lと出力電圧V0との関係を示した図であり、数式では 以下のように表すことができる。◇

Vo ∞ L♦

いま各画素の感度 a i に違いがある場合、各画素の受光 量を L i とすると、その出力電圧 V i は以下のようにな 30 る。ただし、i = 1,2,3,…である。◇

Vi ∝ ai·Li♦

とこで、この固体撮像素子に均一光しを照射した時、すなわちL=L1=L2=L3=…である時においても、各画素の出力電圧Viは以下のようになり、各画素の出力電圧の間に差を生じることがわかる。◆

Vi ∝ ai·L♦

各画素間の出力電圧差がゼロであるためには、均一光Lを与えた時の各画素の出力電圧Viが全て等しくなくてはならない。各画素の感度 ai が全て等しいとすると、各画素の出力電圧Viも全て等しくなるが、感度 ai を全て等しくすることは事実上不可能である。

【0004】そこで従来の固体撮像装置では、各画素間の出力差を以下の演算により補正している。すなわち、対応する画素の出力電圧Viに、各画素の感度aiの逆数を乗じることで補正を行っている。補正後の出力電圧Vi'を数式で示すと以下のようになる。◇

Vi' ∝ (1/ai) Vi◊

∞ (1/ai) · (ai·Li) ◊

∞ Li♦

上記補正演算により、図2に示すように、各画素毎に異なる受光量と出力電圧との関係を基準直線に一致させることができる。従って、どの画素とも同等の受光量・出力電圧特性を有するものとみなして差し支えない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変化する特性を有する固体撮像素子を備えた固体撮像装置においては、上記従来の固体撮像素子と光電変換特性が異るため、上記方法では各画素毎の感度の不均一性を補正することができない。

【0006】本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変化する特性を有する固体撮像素子を備えた固体撮像装置において、各画素間の感度の不均一性を補正することが可能な固体撮像装置を提供することを目的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の固体撮像装置は、「均一光照射時の撮像データを各画素毎に記憶する記憶手段」と、「実際の撮像時における各画素毎の撮像データから上記記憶手段に記憶された対応する画素の撮像データを減算することにより固体撮像装置各画素間の感度の不均一性を補正する補正手段」とを有する。

[0008]

【作用】図3は、受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変化する特性を有する固体撮像素子の受光量しと出力電圧V0との関係を示した図であり、その関係を数式で表すと以下のようになる。◇

0 V0 ∞ 1nL♦

とこで各画素毎の感度 a i に不均一性がある場合、各画素の受光量をLi とすると、その出力電圧Vi は以下のようになる。◇

Vi ∝ ln(ai·Li) ♦

∞ lnai + lnLi◇

ことで感度 a i は各画素毎に異なっているため、均一光 Lを照射した時、すなわちL = L1= L2= L3=…である時でも各画素の出力電圧に差が生じてしまう。この出力電圧差を補正するためには感度 a i を含む項を取り除けばよく、その演算はViより Ina i を減算することで可能となる。補正後の出力電圧Vi'を数式で示すと以下のようになる。◇

Vi' ∝ Vi - lnai♦

∞ (lnai + lnLi) - lnai◇

∞ lnLi◇

上記補正演算により、図4に示すように、各画素毎に異なる受光量と出力電圧との関係を基準直線に一致させる ととができる。従って、どの画素とも同等の受光量・出 力電圧特性を有するものとみなすことができる。

50 [0009]

像撮影時には、D/A変換器にて再度アナログ値に変換 された均一光照射時の各画素毎の撮像データと各画素毎 の実際の撮像データとの差が、アナログ補正演算回路C ORにて演算され、撮像データが補正される。補正され た撮像データは、A/D変換器A/D2にてデジタル値 に変換され、装置DEVに出力される。この様に構成す ることにより、補正演算回路をアナログ回路とすること ができるようになる。

[0014]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、受 光量に対してその出力電圧が自然対数的に変化する特性 を有する固体撮像素子を備えた固体撮像装置において、 被写体の撮像データから均一光照射時の撮像データを減 算する事により、各画素間の感度の不均一性を補正が可 能となる。また、補正のための演算は加減算のみでよい ので、演算が簡単でスピードも速くできるという効果も 有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】受光量に対してその出力電圧がリニアに変化す る特性を有する固体撮像素子の受光量・出力電圧特性を 示した図。

【図2】受光量に対してその出力電圧がリニアに変化す る特性を有する固体撮像装置の受光量・出力電圧特性の 画素による違いを示した図。

【図3】受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変 化する特性を有する固体撮像素子の受光量・出力電圧特 性を示した図。

【図4】受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変 化する特性を有する固体撮像素子の受光量・出力電圧特 性の画素による違いを示した図。

【図5】本発明の実施例のブロック図。

【図6】受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変 化する特性を有する固体撮像素子における均一光照射時 の出力例を示した図。

【図7】受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変 化する特性を有する固体撮像素子の感度の不均一性の補 正結果を示した図。

【図8】受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変 化する特性を有する固体撮像素子に与えた光分布を示し

【図9】上記図8の光分布を受けた受光量に対してその 出力電圧が自然対数的に変化する特性を有する固体撮像 素子の出力を示した図。

【図10】上記図9の出力に感度の不均一性の補正を行 った結果を示した図。

【図11】本発明の別実施例のブロック図。

【符号の説明】

MEM メモリー

COR 補正演算回路

【実施例】図5は、本発明を適用した固体撮像装置のブ ロック図である。CCDは受光量に対してその出力電圧 が自然対数的に変化する特性を持つ固体撮像素子であ る。A/Dは、前述の固体撮像素子CCDより出力され た電圧をデジタル変換するためのA/D変換器である。 MEMは、前配A/D変換器により変換されたデジタル 値を記憶するためのメモリーで、RAM又はPROM等 によりなる。とのメモリーMEMには、前記固体撮像素 子CCDに所定の均一光を照射した時の、各素子の出力 電圧が記憶される。CORはデジタル補正演算回路であ 10 り、画像撮影時に、前記A/D変換器により変換された 固体撮像素子CCDの出力電圧を、メモリーMEMに記 憶された均一光照射時の固体撮像素子CCDの出力電圧 により補正し、補正された画像データを装置DEV(記 憶装置、プリンター等)に出力する。

【0010】以下図6から図10を用いて、受光量に対 してその出力電圧が自然対数的に変化する特性を有する 固体撮像素子の感度の不均一性の補正例を示す。図6に おいて、Aは、受光量に対してその出力電圧が自然対数 的に変化する特性を有する固体撮像素子に、ある明るい 20 均一な光(以下Aレベル光)を照射した時の出力例であ る。また同図におけるBは、上記固体撮像素子に、Aレ ベル光よりも暗い均一な光(以下Bレベル光)を照射し た時の出力例である。ととで各画素毎に、Aレベル光の 出力よりBレベル光の出力を減算すると、図7のように なり、各画素毎の感度ばらつきを補正できることがわか る。

【0011】次に、実際の画像を受光する場合について 述べる。受光量に対してその出力電圧が自然対数的に変 化する特性を有する固体撮像素子上に、図8に示すよう な分布の光を与えた場合、各画素毎の感度の不均一性の ために、その出力は図9のようになり、実際の光分布と は大きく異なってしまう。そとで、図9に示される出力 より、図6のBレベル光による出力を減算する。すると その結果は図10のようになり、固体撮像素子に与えた 光分布と一致する(図8参照)。つまり、実際の画像の 撮影時においても、その撮像データから均一光を照射し た時に得られた各画素毎の撮像データを減算するのみ で、各画素間の感度の不均一性を補正することができ

【0012】図11は、本発明を適用した固体撮像装置 の別実施例のブロック図である。CCDは受光量と出力 電圧が自然対数の関係を有する固体撮像素子であり、A /D1·A/D2はともにA/D変換器である。また、 MEMはメモリー、D/AはD/A変換器、CORはア ナログ補正演算回路、DEVは記憶装置あるいはプリン ター等である。

【0013】均一光照射時の固体撮像素子CCD各画素 の出力電圧は、A/D変換回路A/D変換1によりA/ D変換されて、メモリーMEMに記憶される。そして画 50

【図1】

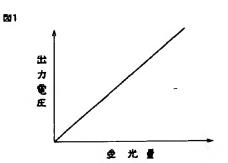
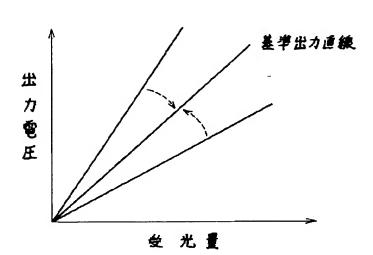


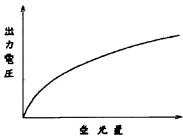
図2



[図2]

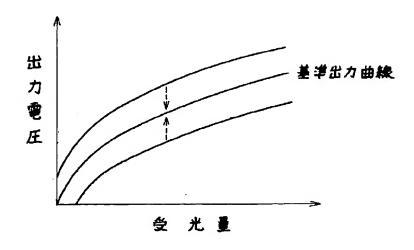
【図3】



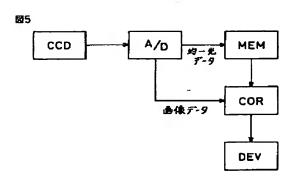


[図4]

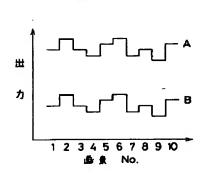
図4



【図5】

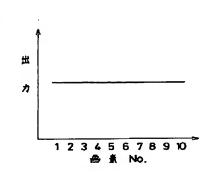


【図6】



[図7]

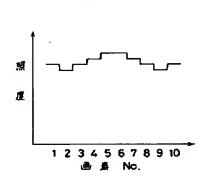
图7



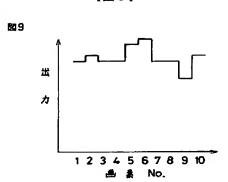
[図8]

⊠8

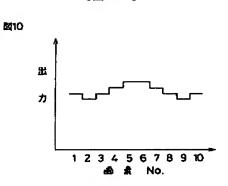
⊠6



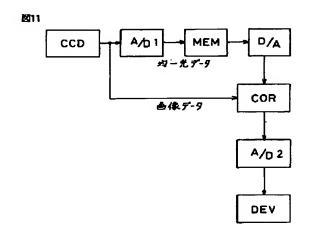
[図9]



【図10】



[図11]



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H O 4 N 1/028

A 9070-5C

P 8838-5C

5/335